



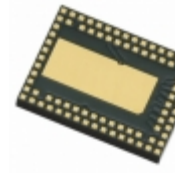




	<h2>SI1022R-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1022R-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A</p> <p>Datenblätter:  SI1022R-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 54367 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1022R-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	54367 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 330mA (Ta) 250mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	250mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	330mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.25 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	30pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1022R-T1-GE3TR

SI1022R-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1022R-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1022R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1022R-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1022R-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A</p>	 <p>SI1023-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1023-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1022-B-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>
 <p>SI1022RR-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI1022R-TI-E3 VISHAY SI1022R-TI-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1022R-T1 VISHAY SI1022R-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1022R-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A</p>

heiße Teile

Mehr

SI1013CX-T1-GE3	SI1013CX-T1-GE3	SI1013R-T1	SI1013R-T1-E3	SI1013R-T1-E3
SI1013R-T1-GE3	SI1013R-T1-GE3	SI1013X-T1	SI1013X-T1-E3	SI1013X-T1-E3
SI1013X-T1-GE3	SI1013X-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016X-T1-E3
SI1016X-T1-E3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X2-T1-GE3	SI1021R-T1
SI1021R-T1-E3	SI1021R-T1-E3	SI1022R-T1	SI1022R-T1-E3	SI1022R-T1-E3
SI1022R-T1-GE3	SI1022R-TI-E3	SI1023CX-T1-GE3	SI1023CX-T1-GE3	SI1023X-T1
SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-GE3	SI1023X-T1-GE3	SI1024-T1
SI1024X-T1	SI1024X-T1-E3	SI1024X-T1-E3	SI1024X-T1-GE3	SI1024X-T1-GE3
SI1024X-TI-GE3	SI1025X-T1	SI1025X-T1-E3	SI1025X-T1-E3	SI1026X-T1
SI1026X-T1-E3	SI1026X-T1-E3	SI1026X-T1-GE3	SI1026X-T1-GE3	SI1028X-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

